

2026年3月期 第3四半期 決算説明資料

2026年 2月13日

トレックス・セミコンダクター株式会社

世界は「アナログ」でできている

あらゆるフィールドで活躍するトレックスの電源IC



1

2026年3月期 第3四半期業績

2

2026年3月期 業績予想

3

株主還元

4

トピックス

Appendix

▶ **トレックスは、アジア以外の全ての地域が回復し、増収増益**

▶ **フェニテックは、北米市場の売上が減少するも、経費抑制の取組みにより、減収増益**

▶ **3Qまでの実績と足元の事業環境を踏まえ、2/9に2026年3月期の業績予想の修正を発表**

2026年3月期 第3四半期業績

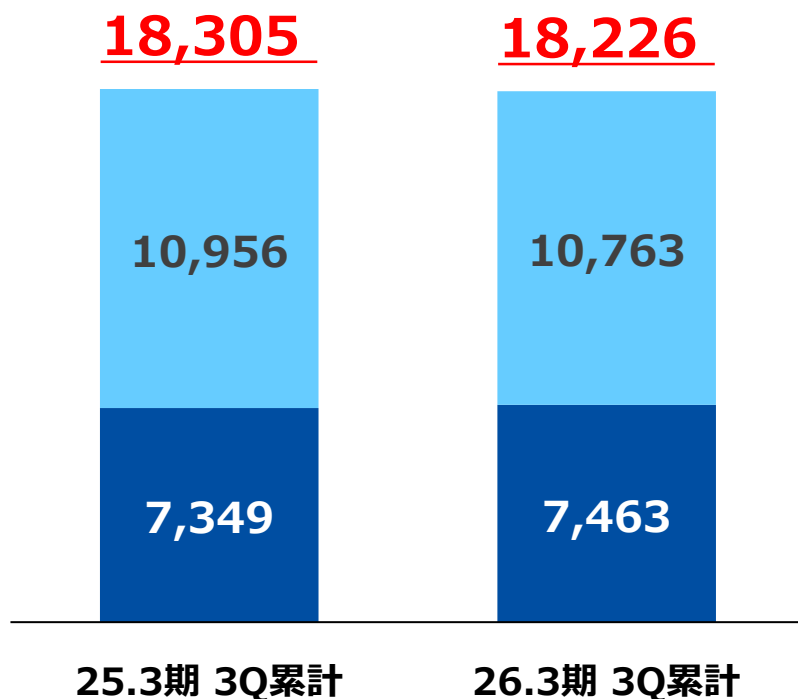
(単位：百万円)

	25.3期 3Q累計実績	26.3期 3Q累計実績	対前年同期比 増減率
売上高	18,305	18,226	▲0.4%
営業利益	▲104	695	-
営業利益率	▲0.6%	3.8%	4.4pt
経常利益	▲173	757	-
親会社株主に 帰属する四半期純利益	▲234	580	-
EPS（円）	▲21.30	54.73	-
海外売上高比率（*1）	69.7%	71.1%	1.4pt
平均為替レート（1\$=）	¥152.8	¥149.3	-
減価償却費	1,760	1,473	▲16.3%
設備投資	2,487	2,120	▲14.8%

（*1）海外売上高比率：外貨建て売上比率

(単位：百万円)

■ : トレックス
■ : フェニテック寄与分



➤ トレックス

- アジア以外の全ての地域が回復し、増収
- 産業機器、医療機器、ウェアラブル機器分野が増加

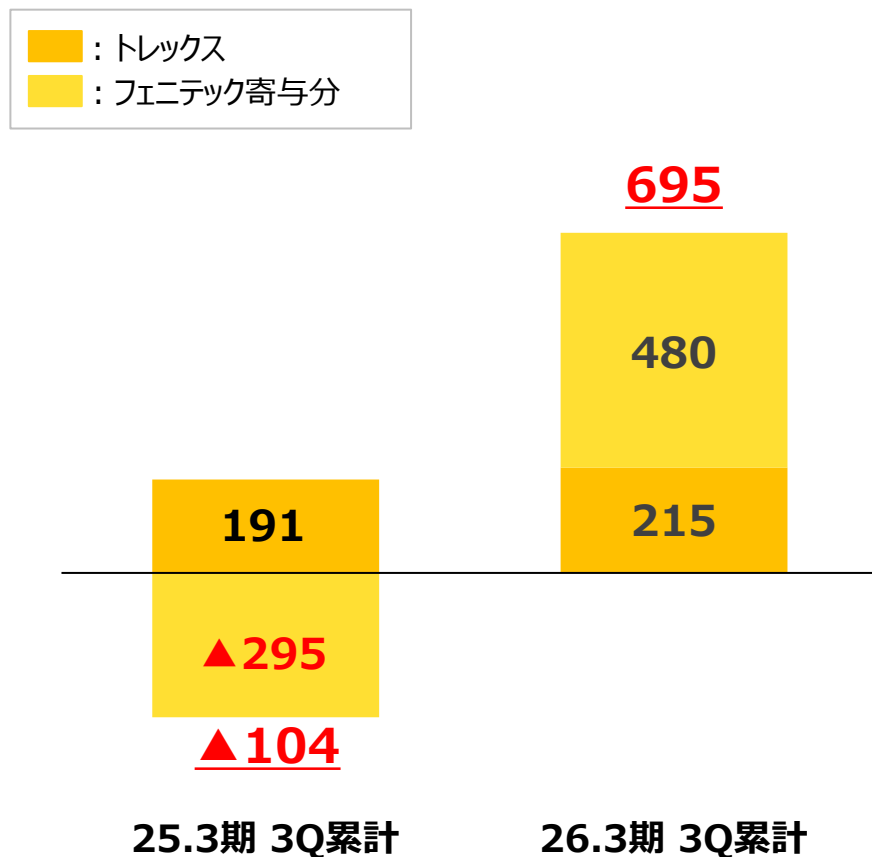
➤ フェニテック

- 北米市場の減少に伴い、減収
- 産業機器分野が減少

(単位：百万円)

	25.3期 3Q 累計実績	26.3期 3Q 累計実績	対前年同期比増減率
売上高	18,305	18,226	▲0.4%

(単位：百万円)



➤ トレックス

- 売上増加の影響により増益

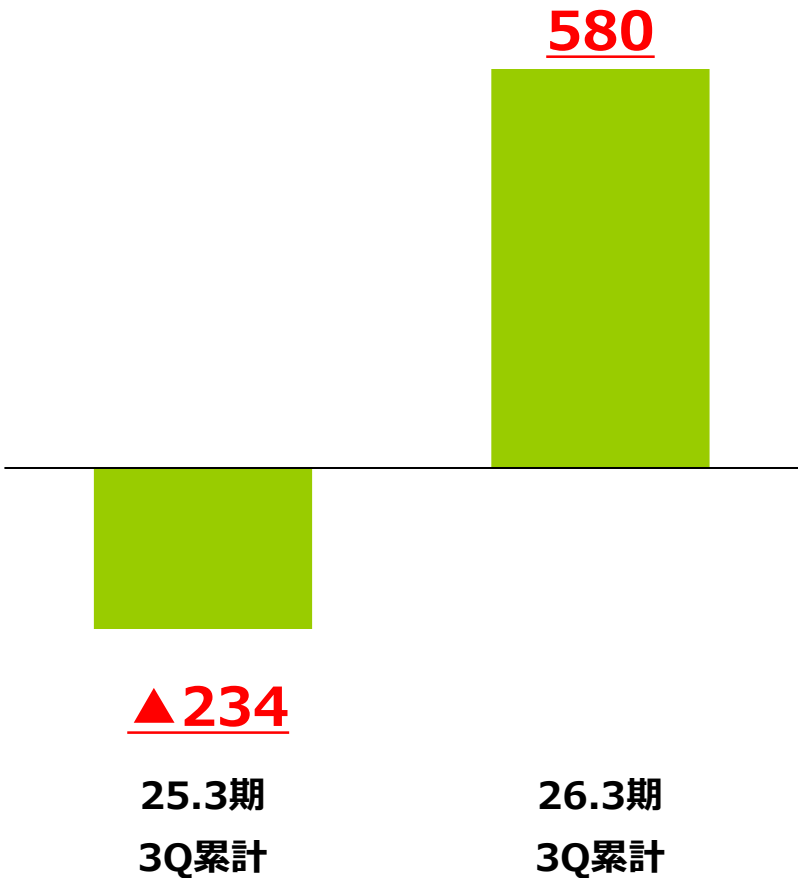
➤ フェニテック

- 経費抑制の取組みの効果により増益

(単位：百万円)

	25.3期 3Q累計実績	26.3期 3Q累計実績	対前年同期比増減率
営業利益	▲104	695	-

(単位：百万円)



営業利益の増加と、為替差損の減少により、増収

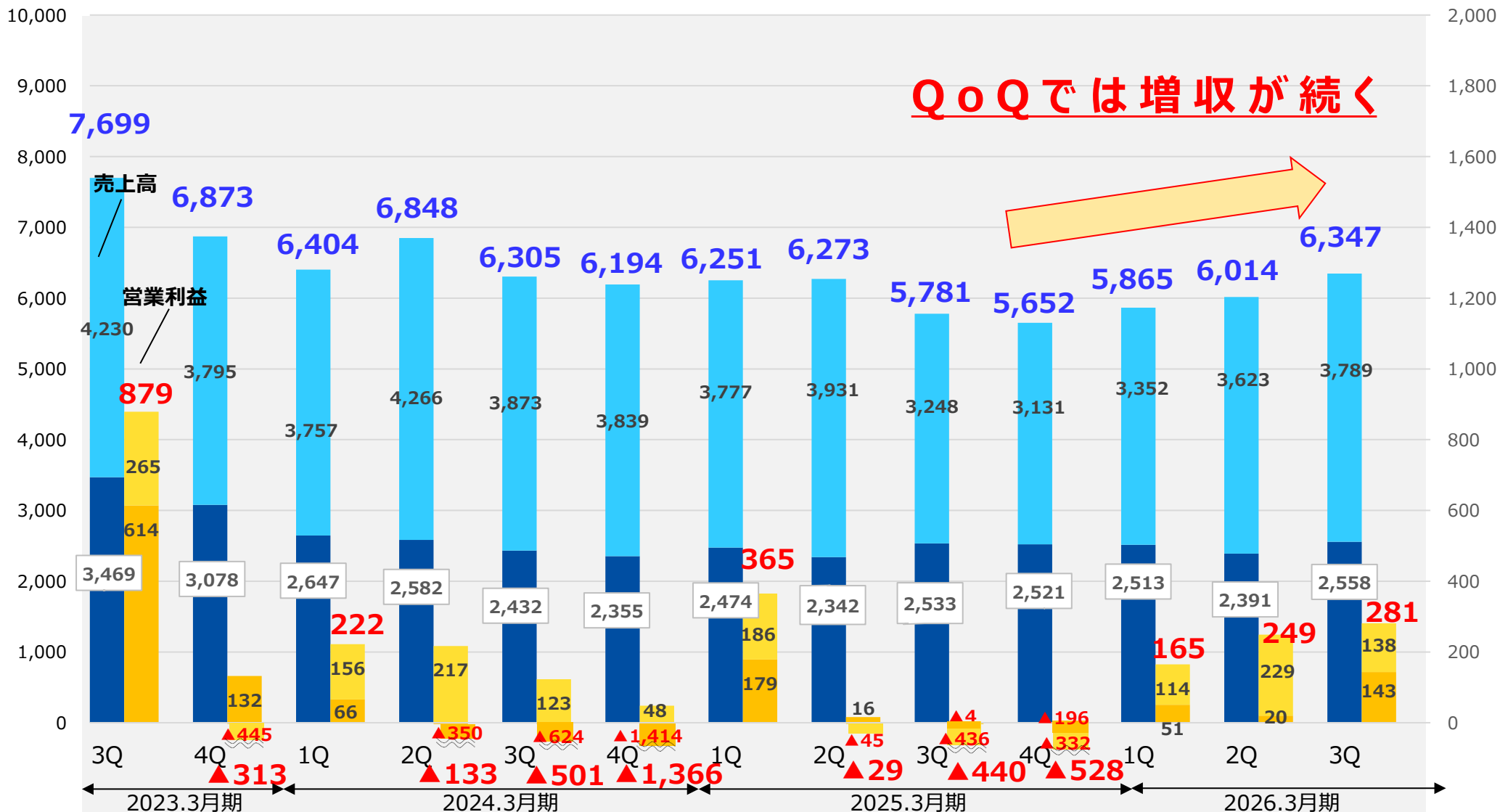
(単位：百万円)

	25.3期 3Q累計実績	26.3期 3Q累計実績	対前年同期比増減率
四半期純利益	▲234	580	-

売上高・営業利益の四半期推移

(左軸：売上高) トレックス : ■ ■
(単位：百万円) フェニテック : ■ ■

(右軸：営業利益)
(単位：百万円)



(単位：百万円)

	25年3月期末	26年3月期 3Q末	対前期末増減
資産	33,607	35,298	1,691
負債	16,207	17,700	1,493
純資産	17,400	17,597	197

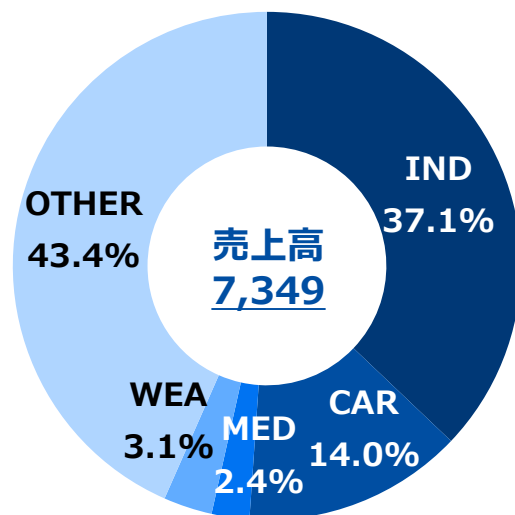
<参考> キャッシュ・フロー関連指標の推移

	25年3月期末	26年3月期 3Q末	対前期末増減
有利子負債	12,984	13,899	915
自己資本比率	51.8%	49.9%	▲1.9pt
D/Eレシオ	0.74	0.79	0.05pt

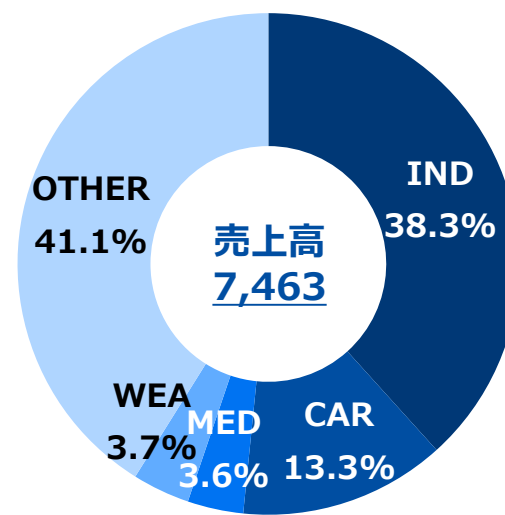
トレックス／フェニテック 各単体

2026年3月期 第3四半期業績 ～アプリケーション別売上高（トレックス）

TOIREX



25.3期3Q累計実績



26.3期3Q累計実績

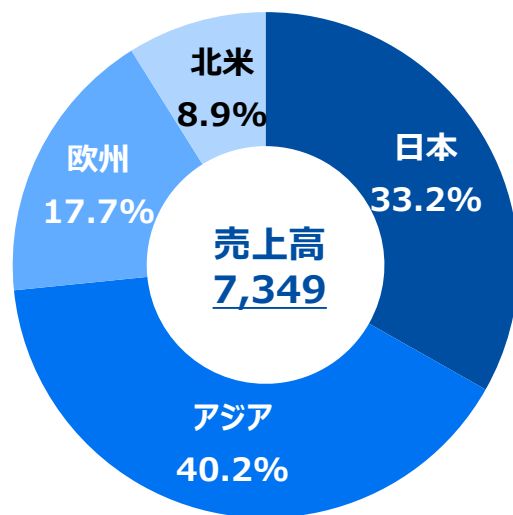
(単位：百万円)

アプリケーション		25.3期 3Q累計		26.3期 3Q累計		対前年同期比 増減率
		売上高	構成比	売上高	構成比	
IND	産業機器	2,727	37.1%	2,861	38.3%	4.9%
CAR	車載機器	1,030	14.0%	995	13.3%	▲3.4%
MED	医療機器	179	2.4%	266	3.6%	48.6%
WEA	ウェアラブル機器	229	3.1%	273	3.7%	19.2%
OTHER	その他機器	3,184	43.4%	3,068	41.1%	▲3.6%

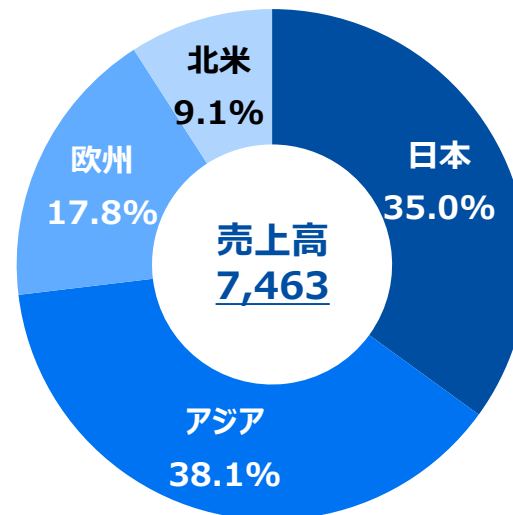
※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。

2026年3月期 第3四半期業績 ～地域別売上高（トレックス）

TOIREX



25.3期3Q累計実績



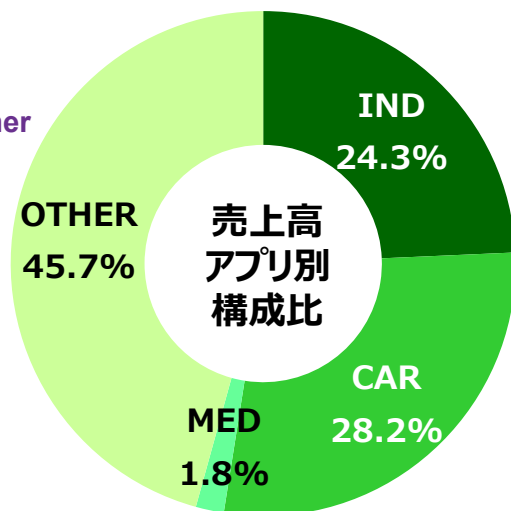
26.3期3Q累計実績

(単位：百万円)

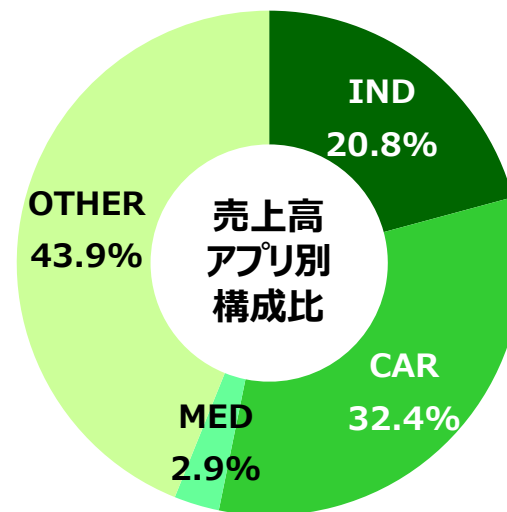
地域 (D-in)	25.3期 3Q累計		26.3期 3Q累計		対前年同期比 増減率
	D-in 売上高	構成比	D-in 売上高	構成比	
日本	2,440	33.2%	2,614	35.0%	7.1%
アジア	2,953	40.2%	2,842	38.1%	▲3.8%
欧州	1,299	17.7%	1,331	17.8%	2.5%
北米	657	8.9%	676	9.1%	2.9%
平均為替レート (1\$=)	152.8円		149.3円		

D-in 売上高：デザイン・イン・ベース売上高。当社の製品を搭載した製品が企画・設計され、実質的に受注を獲得した地域をベースとした売上高

2026年3月期 第3四半期業績 ～アプリケーション別売上高（フェニテック）：参考値



25.3期3Q累計実績



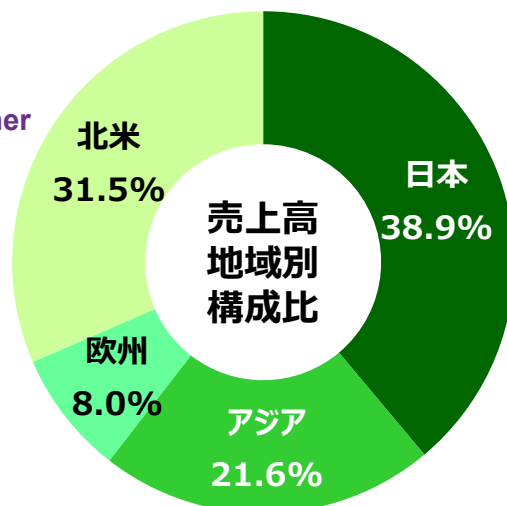
26.3期3Q累計実績

(単位：百万円)

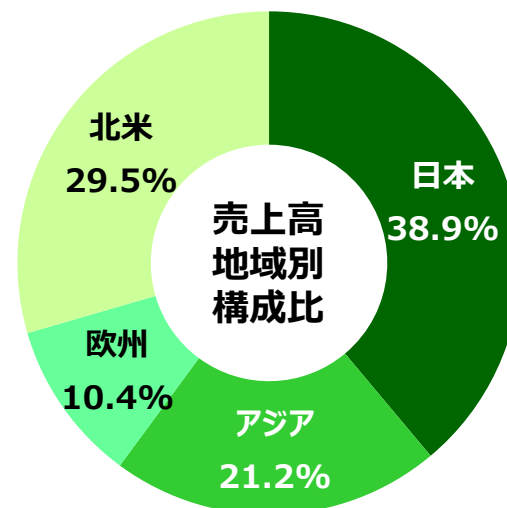
アプリケーション		25.3期 3Q累計		26.3期 3Q累計		対前年同期比 増減率
		売上高	構成比	売上高	構成比	
IND	産業機器	2,873	24.3%	2,512	20.8%	▲12.6%
CAR	車載機器	3,330	28.2%	3,907	32.4%	17.3%
MED	医療機器	211	1.8%	347	2.9%	64.5%
OTHER	その他機器	5,395	45.7%	5,298	43.9%	▲1.8%

※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。
トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含みます。
お客様から用途を開示頂けない製品は、その他機器に含めております。

2026年3月期 第3四半期業績 ～地域別売上高（フェニテック）：参考値



25.3期3Q累計実績



26.3期3Q累計実績

※ 顧客の所在地別に区分しています。

(単位：百万円)

地域（顧客）	25.3期 3Q累計		26.3期 3Q累計		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
日本	4,597	38.9%	4,695	38.9%	2.1%
アジア	2,546	21.6%	2,560	21.2%	0.5%
欧州	943	8.0%	1,252	10.4%	32.8%
北米	3,723	31.5%	3,557	29.5%	▲4.5%
平均為替レート（1\$=）	152.8円		149.3円		

※注：日本には、トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む

2026年3月期 業績予想

26年3月期の業績予想を変更しました。

(単位：百万円)

	25.3期 通期実績	26.3期 業績予想 (11/14)	対前年 同期比 増減率	26.3期 業績予想 (2/9)	対前年 同期比 増減率
売上高	23,957	24,500	+2.3%	25,000	+4.4%
営業損益	▲632	600	-	800	-
営業利益率	▲2.7%	2.5%	-	3.2%	-
経常損益	▲820	600	-	800	-
親会社株主に 帰属する当期純損益	▲2,358	400	-	550	-
EPS (円)	▲215.75	39.65	-	51.88	-
平均為替レート (1\$=)	¥152.4	¥145.0	-	¥150.0	-
減価償却費	2,468	2,100	▲14.9%	2,100	▲14.9%
設備投資	2,964	2,740	▲7.6%	2,740	▲7.6%

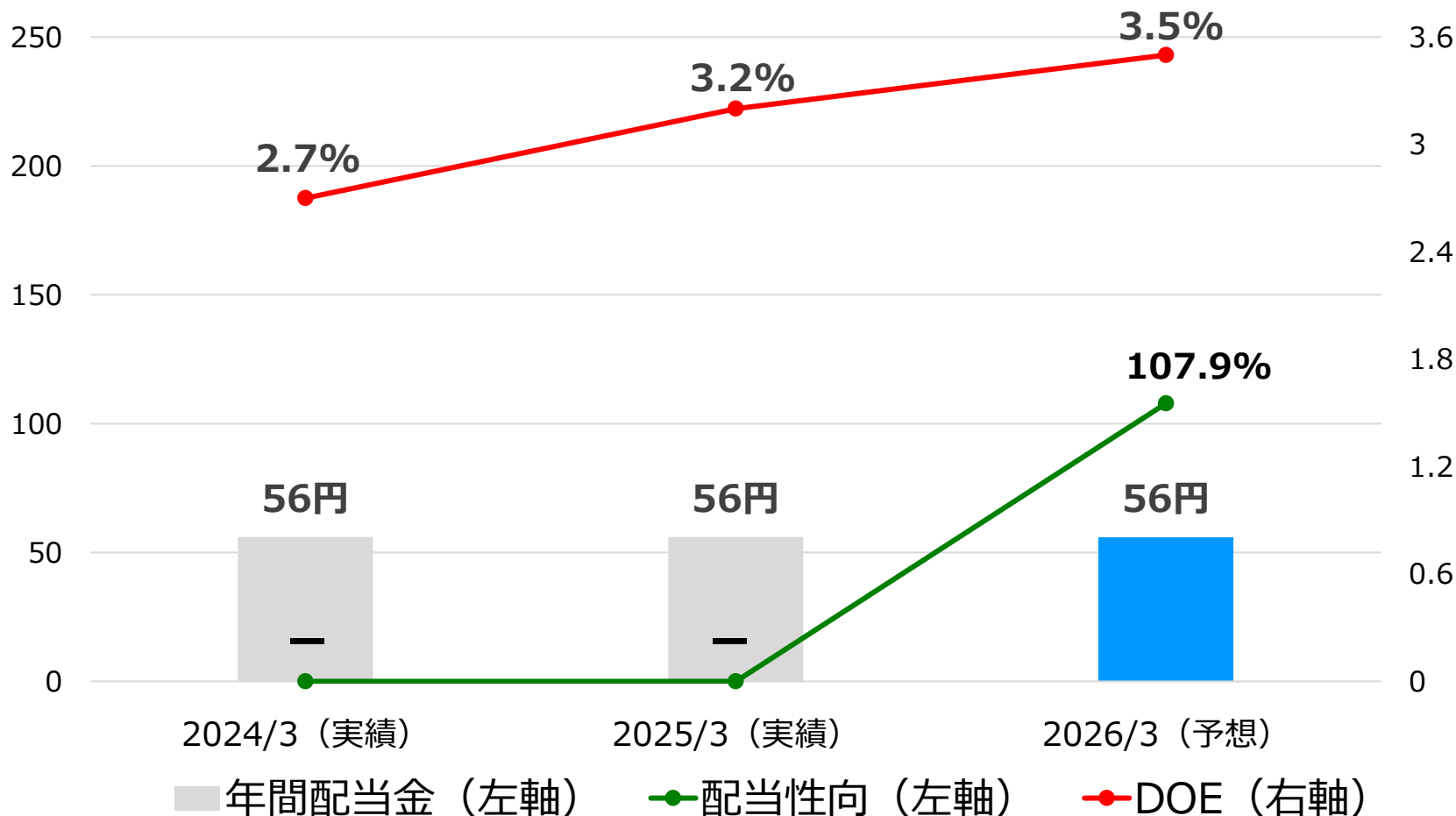
株主還元

配当につきましては、業績水準を反映した利益配分として
連結配当性向20%以上、安定的かつ継続的な株主還元
の拡充として**株主資本配当率（D O E）3%程度**を当面
の目標として実施しております。

連結配当性向20%以上、D O E 3%程度を目標として還元

配当金：円
配当性向：%

DOE：%



トピックス

トレックス・セミコンダクター

11月25日に従業員エンゲージメント向上と 持続的な企業成長を目指し、本社を移転

— ABW導入による働き方改革 環境配慮型オフィスへ —

■新住所

東京都江東区豊洲6-4-34 メブクス豊洲 5階

■本社移転の目的

従業員エンゲージメント向上と持続的な企業成長

■新オフィスのコンセプト

“3つのC”（協働・創造・貢献）

■新オフィスの特徴

【Activity Based Working（ABW）の導入】

業務に応じた多様な空間、全従業員フリーアドレス制、
部門横断コミュニケーション活性化を図る

【従業員ウェルビーイングの向上】

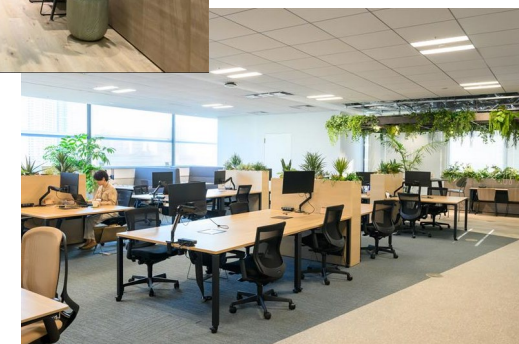
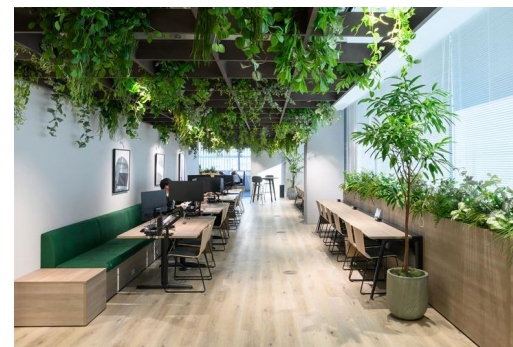
リフレッシュエリア／カフェスペース／オフィス緑化の充実、
マザーズルームを備えた休養室の設置、 実験室の空調環境改善

【環境配慮】

BELSランク5、CASBEE Sランクを取得



※ビル外観



※オフィス内部

突入電流やサージ電流に強い 650V、6A/8A/10A SiC ショットキーバリアダイオード

- ・ XBSC41/XBSC42/XBSC43 シリーズ
- ・ 高速スイッチング動作、低リカバリー損失
- ・ スwitchング電源、白物家電、汎用インバータ
- ・ 力率改善回路、太陽光インバータ、無停電電源

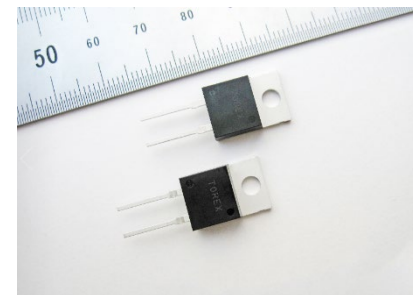


図3. パッケージTO-220AC
(10.29 x 28.69 x 4.75mm)

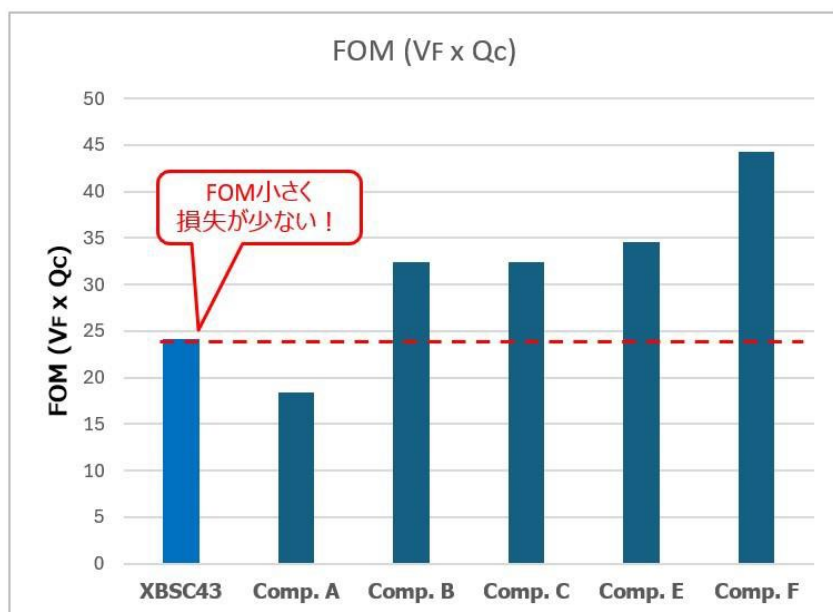


図1. XBSC41/XBSC42/XBSC43シリーズ性能指数 (FOM)

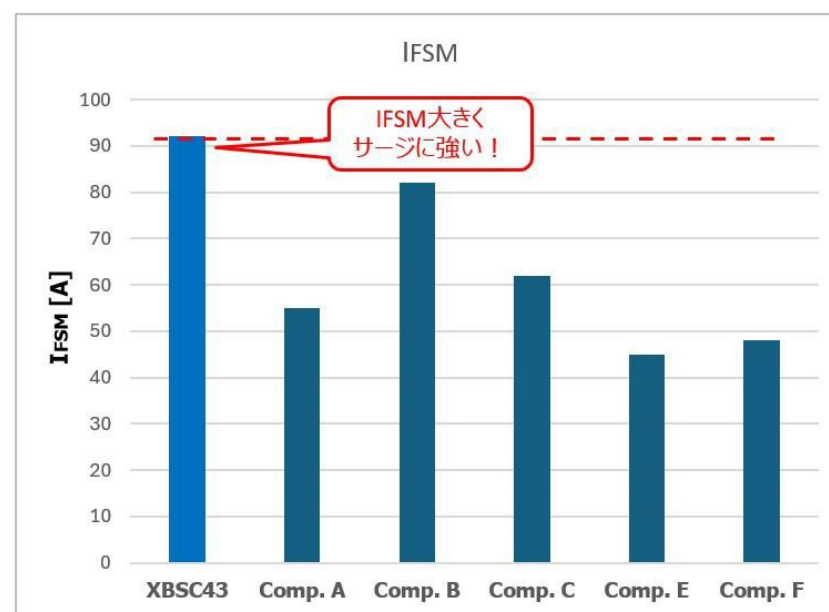


図2. XBSC41/XBSC42/XBSC43シリーズサージ順電流 (IFSM) 耐量

ドライバ内蔵 ブーストラップ同期整流 降压DC/DCコンバータ XC9711 シリーズ

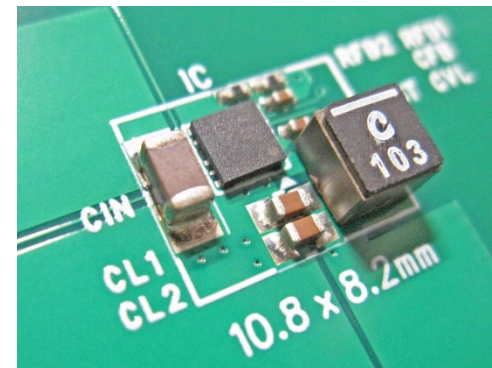
- ・ PWM制御、PWM/PFM自動切換制御の制御選択端子付
- ・ 同期整流 Nch-Nchドライバ FET内蔵
- ・ **DFN3030-12A (3.0×3.0×0.75mm) パッケージ**

製品の特長

- ・ 発信周波数 : 800kHz
- ・ 入力電圧範囲 : 4.5V ~ **60V**
- ・ 出力電圧範囲 : 2.5V ~ 18.0V (外付け抵抗)
- ・ 動作温度 : -40℃ ~ **125℃**
- ・ 機能 : 電流制限、出力過電圧保護、サーマル保護
Lx端子短絡保護、パワーグッド機能、等

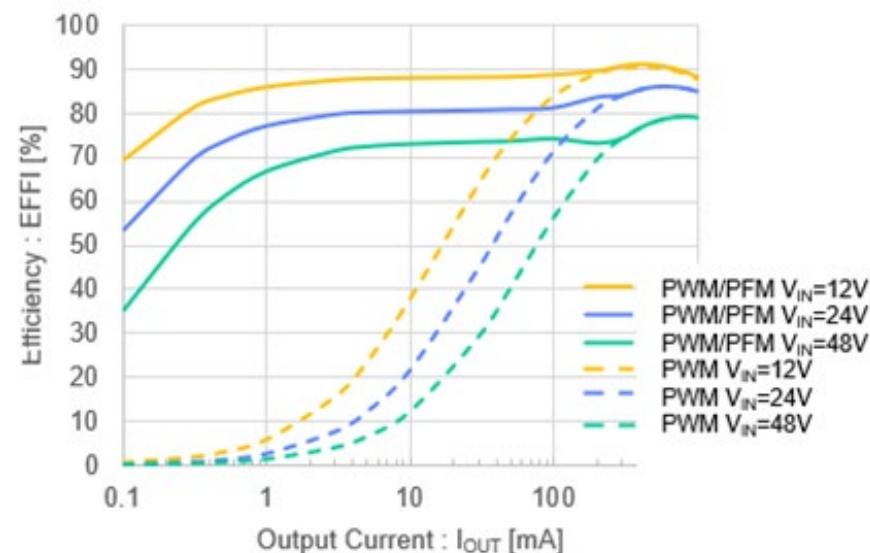
用途

- ・ FAセンサ、工場・ビル設備のセキュリティ機器
- ・ FA機器、産業用センサー、家電製品/電動工具
- ・ 高耐圧60V、低ノイズ、小型省電力ソリューション



XC9711動作基板 (10.8×8.2mm エリア実装)

XC9711シリーズ 電力変換効率グラフ (VOUT=5V)



フィジカルAIは、現実世界の物理空間に直接作用するAIで、センサーを使用して周辺の情報をキャッチし、マイコンで情報処理を行い、モーターなどを使用して実際に動作をさせるものです。

ヒューマノイドロボットなどはイメージし易いと思います。

TRXが培ってきた小型で省電力の電源ICは、センサーやマイコン、モーターなど多くの部分で実際に動作を伴う際に、高性能に活躍できるICとなります。

トレックスの電源ICは、省電力/小型のスペックが評価されています。

2025年度



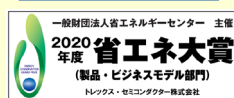
日刊工業新聞主催
XC9704/05シリーズ
降圧DC/DCコンバータ

2023年度



日刊工業新聞主催
XC9145シリーズ
DC/DCコンバータ

2023年度



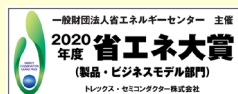
省エネルギーセンター主催
XC8110/
XC8111シリーズ
ロードスイッチIC

2022年度



日刊工業新聞主催
XC8110/
8111シリーズ
ロードスイッチIC

2020年度



省エネルギーセンター主催
XC9276シリーズ
DC/DCコンバータ

2019年度



日刊工業新聞主催
XC9281/
XC9282シリーズ
DC/DCコンバータ

2018年度

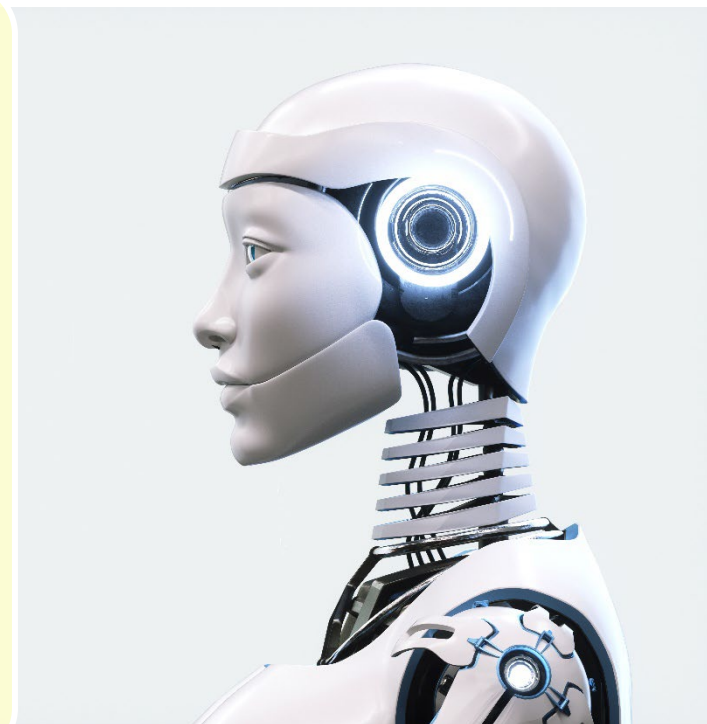


経済産業省主催
XC9265シリーズ
DC/DCコンバータ

2018年度



日刊工業新聞主催
XC6192シリーズ
ロードスイッチIC



12月18日に半導体製品の世界的IDMメーカーであるPANJIT社と、当社の後工程を行うTVS社の持分の95%を譲渡する契約を締結を祝したセレモニーを行いました。

名称	PANJIT INTERNATIONAL INC.
所在地	No. 24, Gangshan N. Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City , Taiwan
売上高 (2023年12月期)	12,707,319千台湾ドル (597億24百万円 / 1台湾ドル=4.7円換算)

トレックスグループのメリット

PANJIT社の製造技術力と、ファブレスメーカーである当社の設計開発力を活かし、相互にシナジー効果を発揮。

パッケージ技術の高度化と全体的な競争力を向上

持分譲渡割合	95%
譲渡価額	10,032,000米ドルを基準として、譲渡実行日時点のTVS社の純資産価額に応じて調整された一定の金額
譲渡契約締結日	2025年11月17日
持分譲渡実行日	TVS社の所有権移転に係る手続き完了後、一定の日



左から: PANJIT社 代表取締役社長 Jeff Fang氏と
トレックス 代表取締役社長 木村岳史

※同社IR資料より抜粋

フェニテックセミコンダクター

ファウンドリ受託

SiC

GaN

GaAs

Ga₂O₃

主要化合物半導体(SiC・GaN・GaAs・Ga₂O₃) デバイスの
ファウンドリをフレキシブルに受託できるのが、当社の“強み”です

ファウンドリ
Ga₂O₃

- ✓ 広いバンドギャップ
- ✓ 高い絶縁破壊電界強度
- ✓ 低スイッチング損失
- ✓ 低コスト基板製造の可能性

Ga₂O₃(酸化ガリウム)とは

酸化ガリウム半導体は、従来のシリコン半導体と比較して、より高い耐圧と低い電力損失を実現できます。ワイドバンドギャップであるため、高温や高周波環境下での動作にも優れています。
また、他の次世代半導体材料に比べて、基板の製造コストを大幅に削減できる可能性があり、電力変換効率の向上やデバイスの小型化に貢献することが期待されています。

ノベルクリスタルテクノロジー社よりファウンドリを請け負い、
酸化ガリウムデバイスの試作生産を行なっています

生産ノウハウの蓄積

- ✓ 次世代パワー半導体材料として注目されるGa₂O₃の
ファウンドリにいち早く対応、Ga₂O₃デバイス開発を推進
・生産の顧客ニーズに応え続けていきます

ファウンドリ SiC

- ✓ 広いバンドギャップ
- ✓ 高い絶縁破壊電界強度
- ✓ 高い電子移動度
- ✓ 高い熱伝導率
- ✓ 低いオン抵抗

SiC(炭化ケイ素)とは

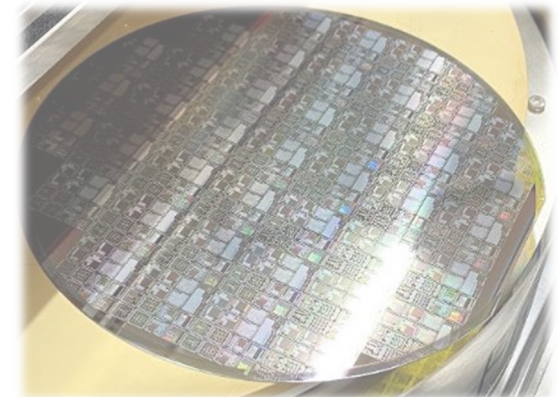
SiC半導体は、シリコンに対し高耐圧・高耐熱性、低損失、高速動作に優れます。これにより、電力変換効率が向上し、デバイスの小型化・軽量化が可能です。

応用分野は多岐に渡り、特に電気自動車のインバータやオンボードチャージャー、鉄道車両の駆動システム、産業機器のパワーコンディショナ、再生可能エネルギー分野などで実用化が進んでいます。高効率な電力制御を実現し、省エネルギー化に貢献する次世代パワー半導体として注目されています。

- ・ 当社SiCファウンドリは、SBD,MOSFET以外にも、要素開発・試作フェーズのものを含めると様々な製品の生産を担っています

生産ノウハウの蓄積

- ✓ 今後も、ますます増えていくSiCデバイスの顧客ニーズにフレキシブルに応え続けていきます



SiC製品開発

新たなパワーデバイス開発により更なる売上アップを目指す

SBD

自社開発品

650V 10A Gen.2,3

650V 20A Gen.2,3

1200V 10A Gen.2,3

650V 6,8,10A Gen.4

✓ 今後も市場要望にスピーディなシリーズ拡充で対応

- ・第4世代 量産開始
- ・第2,3,4世代 サンプル提供中/顧客評価中
- ・目標耐圧2200V,3300V品を開発中

MOS FET

自社開発品

1200V 20A Planar/Trench

1200V 40A Planar

1200V 80A Planar

✓ 電流ラインナップシリーズ展開 試作中

プレーナー型

- ・サンプル提供中/顧客評価中 27.3期Q2量産予定
- ・ベースプロセスライン完成 ラインナップ化を進める
(1200V 40A /1200V 80A)

トレンチ型

- ・開発中

SiCIC社会実装プロジェクト



広島大学



For Further Growth Together

Roadmap

Step1.

SiC-IC PDK整備と応用開拓

Step2.

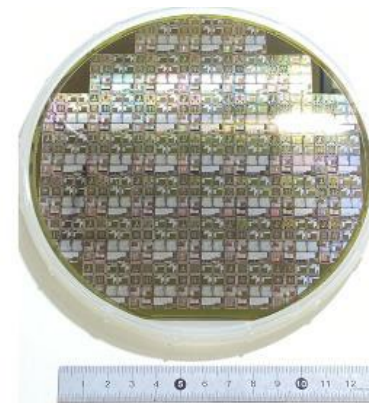
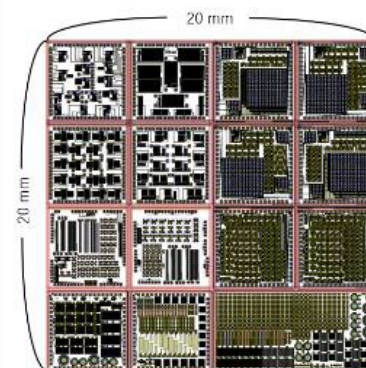
システム側研究開発パートナー拡大

Step3.

パートナーをシステムメーカーに拡大



SiCデバイス生産拠点
鹿児島工場



左は試作製造された集積回路などの図面
右は試作製造されたSiCウェハー

広島大学 学長定例記者会見(2025.4.24)で公式発表となった、広島大学黒木副所長及びその研究チームとの共同研究「SiCIC社会実装プロジェクト」を当社は強力に推進しております。

当プロジェクトは、その目的である「原発の廃炉対応や金星探査など高温／高放射線などの極限環境応用に向けたSiC LSIのプラットフォームの立上げ」に向けて、**Step1.**を継続中であり、当社鹿児島工場で生産したSiC集積回路の評価を進めています。

Si製品開発

新たなパワーデバイス開発により更なる売上アップを目指す

Low Vth MOSFET

量産中

- ・製品ラインナップ拡充を継続

スプリットゲート型MOSFET

60V

プロセス開発成功し、狙い特性獲得

- ・26.3期Q4 量産予定
- ・製品ラインナップ拡充を継続

30V

40V

100V

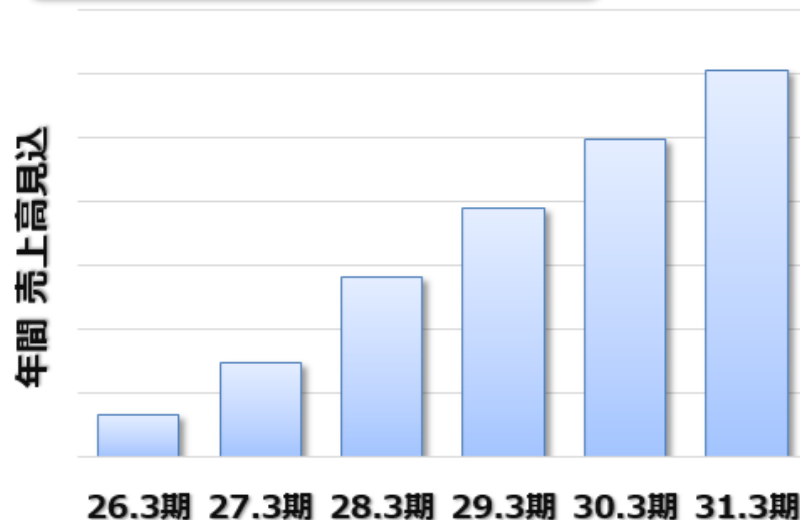
150V

ファウンドリ受託

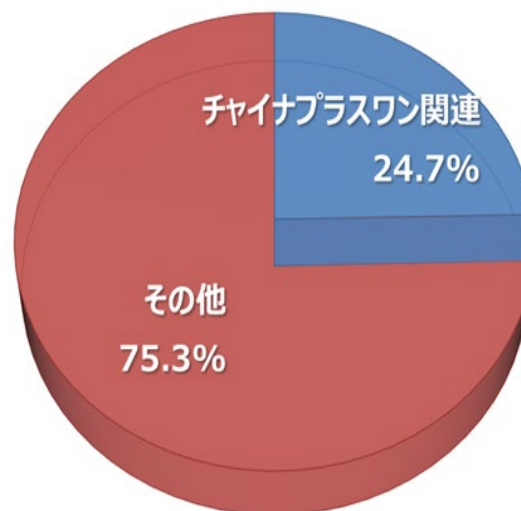
新規受注案件

- ✓ 小信号ディスクリート、TVS、パワーデバイスを中心に多種製品の受注があり、幅広い製品受託が可能な当社の“強み”が市場に支持されています
- ✓ 中華圏企業のチャイナプラスワン戦略や、不安定な市場環境の中、30年以上の歴史を誇る当社ファウンドリ事業の安定性が支持され、受注が増加しています

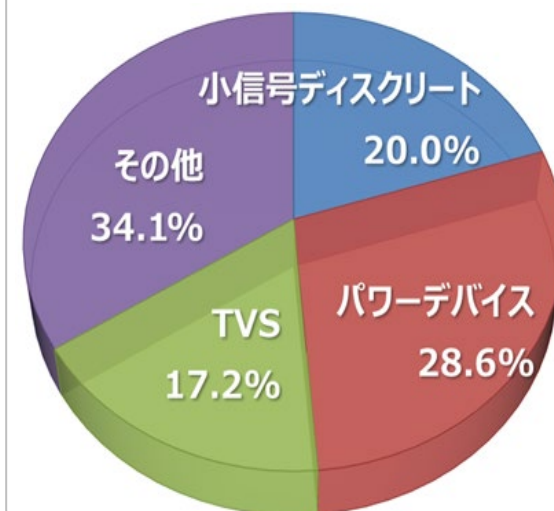
新規受注案件 売上高見込み



「チャイナプラスワン」関連比率



新規受注案件製品比率



- ▶ 中国一極集中を避け生産拠点を分散する各社のリスクヘッジ戦略は続くの見込み、チャイナプラスワン戦略関連案件を積極的に取り込みます
- ▶ 受託可能な幅広い製品受託を推進する全方位戦略を敷き、今後もあらゆる可能性を新規受注に繋げていきます

SEMICON Japan 2025

中四国パビリオン

初出展

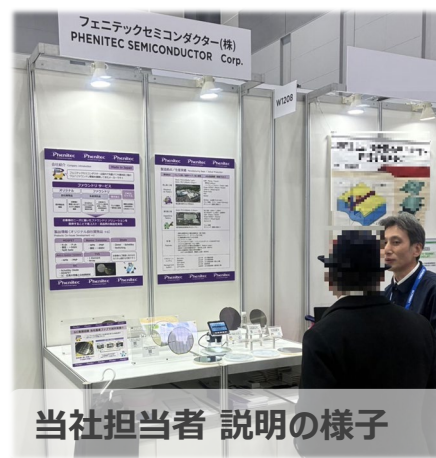
✓ 次回セミコンジャパン2025 中四国パビリオン に初出展しました

開催日 2025年12月17日(水) ~ 19日(金)

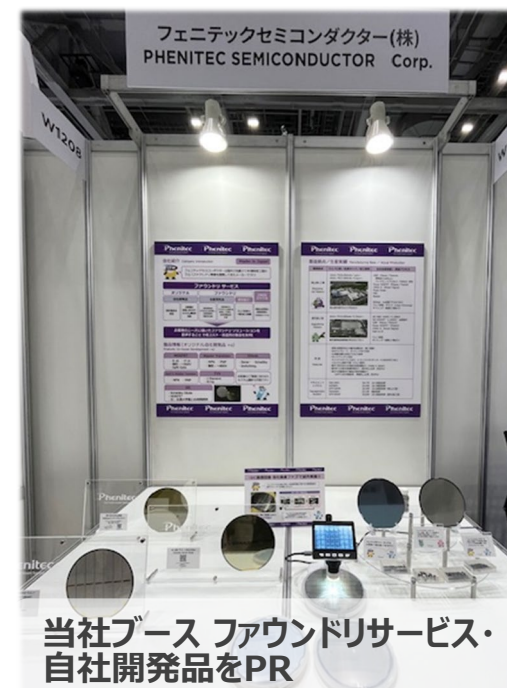
会場 東京ビッグサイト 西1ホール



SiC・Si自社開発品などウェハーを展示



当社担当者 説明の様子



当社ブース ファウンドリサービス・
自社開発品をPR

SiC-化合物-Siファウンドリ企業としての魅力を存分に発信してまいりました。展示ウェハーを中心とした当社生産品などに対して、数多くのお問い合わせをいただきました。各種メーカー様を中心に多数の具体的な商談案件を受け、今後の大きなビジネスへの進展に期待しています。

先進パワー半導体分科会 第12回講演会

2025.11.20 講演

開催日 2025年11月19日(水) ~ 20日(金)

主催 公益社団法人応用物理学会 先進パワー半導体分科会

会場 富山国際会議場

講演内容 貼り合わせSiC基板を使ったパワーデバイス開発
Development of Power Device Fabricated on 4H-SiC Bonded Substrate



当社技術担当者登壇の様子

当社所属社員が、2025年11月20日に開催された「先進パワー半導体分科会 第12回講演会」において、研究成果を発表いたしました。

今回の講演内容は、当社社員が出向先 産業技術総合研究所(以下、産総研)における業務を通じた研究成果になります。

当社は出向制度を通じ、社員に新たな知識や経験を取得してもらうと共に、半導体技術の発展に貢献することを目的に、産総研が推進する半導体分野の最先端研究に参画しております。

今後とも、産総研の研究推進の一助となり、半導体産業の発展に貢献できるように取り組んでまいります。

せとうち半導体コンソーシアム セミナー

せとうち半導体コンソーシアム

組織 会員

広島大学半導体産業技術研究所を中心とした産学連携組織
(正会員)：企業32社、2大学、産総研・広島県・東広島
(特別会員)：中国経産局 (賛助会員)：1団体

ミッション

「半導体産業を核とした新たな経済価値創出」、「環境配慮型のファブ・産業集積への基盤技術創出」による我が国の半導体産業再興・さらなる成長への貢献

開催日 2025年12月15日(月)

主催・共催 広島大学半導体産業技術研究所
せとうち半導体コンソーシアム

会場 広島大学半導体産業技術研究所 Jイノベ棟 1 F

講演内容 貼り合わせSiC基板を使ったパワーデバイス技術

2025年12月15日「せとうち半導体コンソーシアム セミナー」において、当社技術担当者が講師として登壇し、貼り合わせ基板と当社で製造した様々なパワーデバイスを紹介いたしました。学术界・産業界の専門家が集う場での発表は、当社の技術力広く発信する貴重な機会となり、また、同コンソーシアムの目的である「半導体産業の中核を担う人材を育成」に対して貢献させていただいた、大変意義深い場となりました。

Powerfully Small!

常に豊かな知性と感性を磨き、
市場に適応した価値ある製品を創出し、
豊かな社会の実現と
地球環境の保全に貢献するとともに、
私たちの事業に携わるすべての人々が
共に繁栄すること



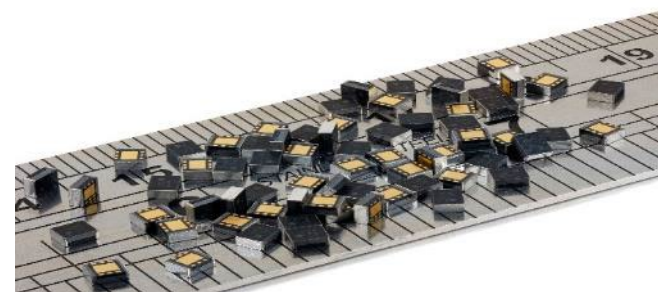
Appendix 会社紹介

1995年に設立。2014年にJASDAQスタンダード市場に上場、東証二部、一部を経て、2022年4月に東証プライム市場に移行した半導体メーカーです。

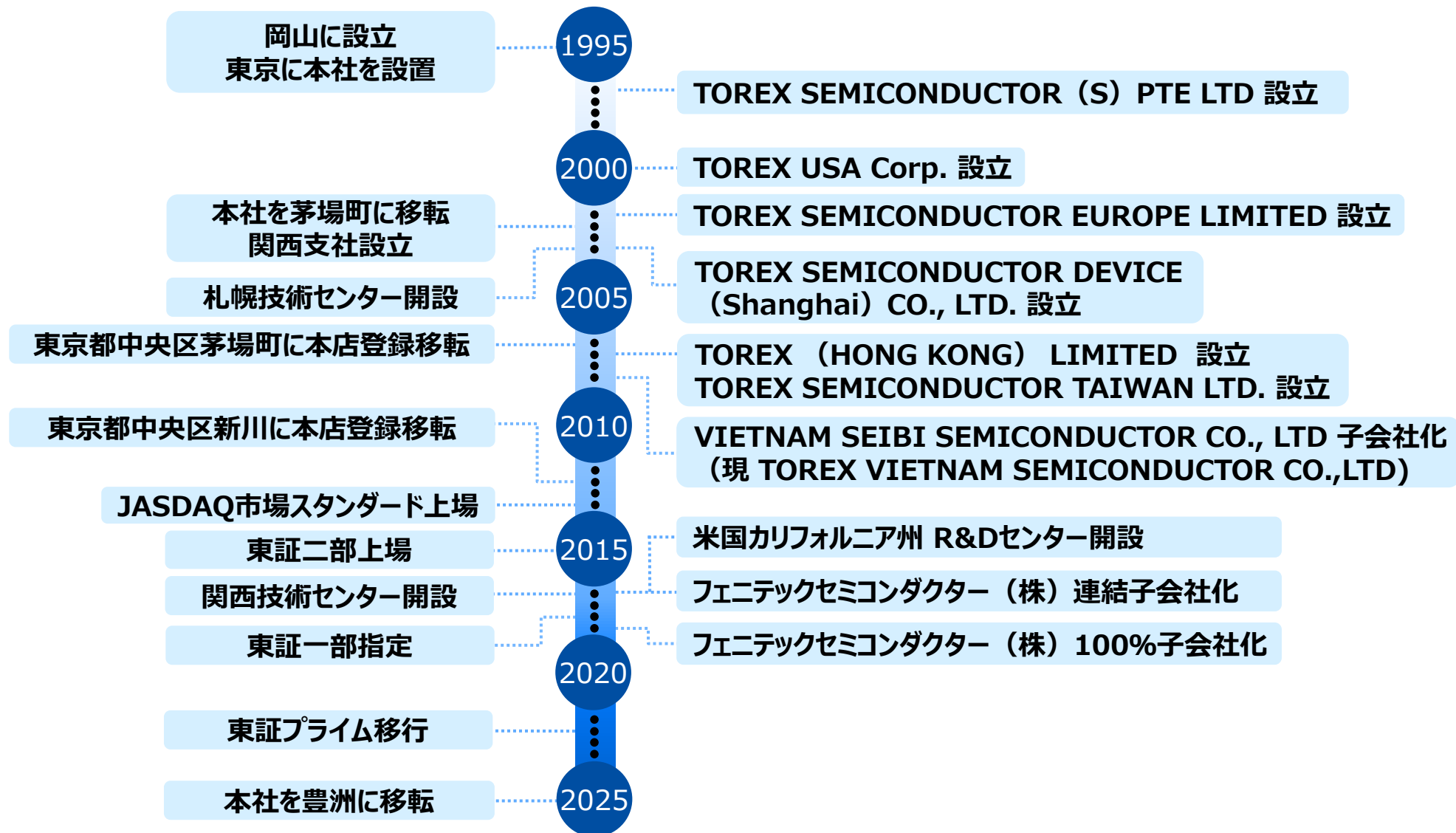
アナログのチカラ
ABOUT TOREX

所在地	東京都江東区豊洲6-4-34 メブクス豊洲 5階
代表者	代表取締役社長 木村 岳史
資本金	29億6793万円（2025年12月31日現在）
事業内容	1.半導体デバイスの開発、設計製造 2.半導体デバイスの販売
従業員数	当社：185名 / グループ：1,038名
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場
単元株式数	100株
決算期	3月末日
証券コード	6616
URL	https://www.torex.co.jp/

常に豊かな知性と感性を磨き、市場に適応した価値ある製品を創出し、豊かな社会の実現と地球環境の保全に貢献するとともに、私たちの事業に携わるすべての人々が共に繁栄することを企業の理念とする。



電源IC一筋、**省電力・小型化**の技術でエレクトロニクス産業の発展に貢献してきました。



TOIREX



トレックス・ セミコンダクター

**ファブレスメーカー
アナログ電源IC専業**

強
み

- ・省電力／小型化の技術
- ・蓄積されたアナログ回路ノウハウ
- ・マーケティングと製品企画力
- ・フレキシブルな生産工場
- ・高品質をキープするQC
- ・ワールドワイドの製品販売網

Phenitec
For Further Growth Together



フェニテック セミコンダクター

**半導体受託専業(ファウンドリ)
ディスクリート、パワーデバイス、
CMOSアナログプロセス**

強
み

- ・高品質を支える生産ノウハウ
- ・長期安定供給のJapanFab
- ・車載 IATF16949取得工場
- ・専門性の高い製造対応力
- ・オリジナルデバイスの開発力
- ・パワーデバイスの開発力



トレックス・ セミコンダクター グループ

- ・顧客第一に徹した、小回りの利く対応力
- ・積極的なコラボレーションやM&Aによる協力関係の構築

**ファブレス&ファウンドリ
それぞれが本業を突き詰めたプロ集団となり、
相互補完でシナジーを発揮する。**

- 国内に東京本社を含む 8 拠点、海外に9つの拠点を設け、世界の需要に対応しています。



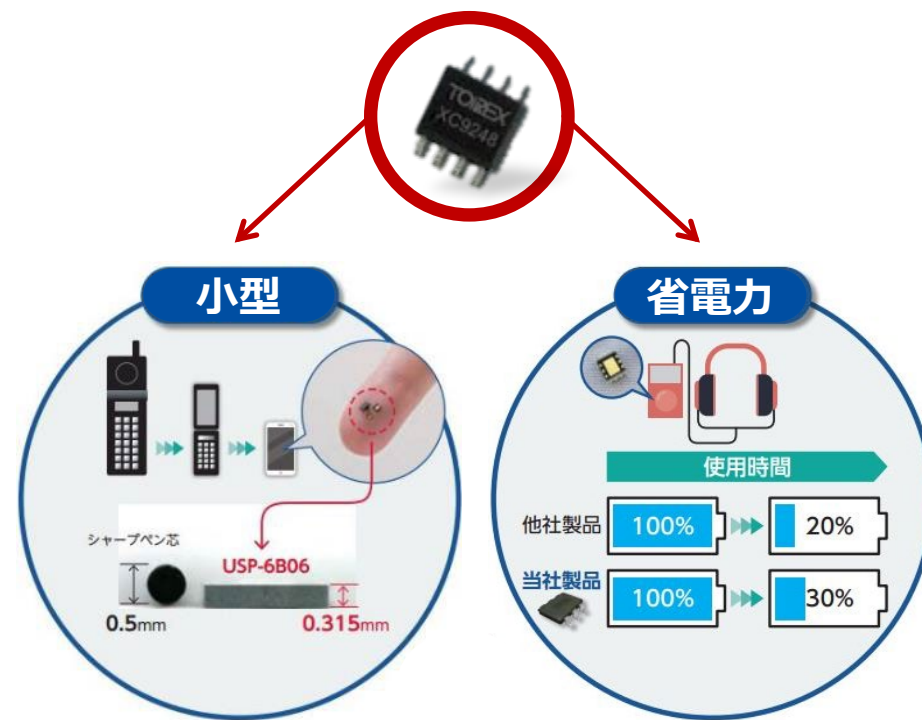
- 世界トップクラスの小型・省電力電源ICを開発・販売しています。

電源ICの役割



電子機器の様々な機能を動かすために
電圧を制御し安定供給する

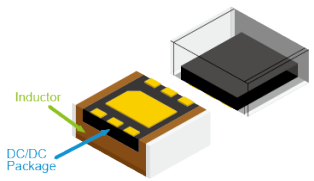
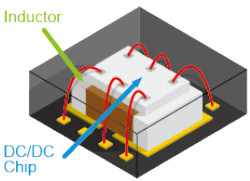
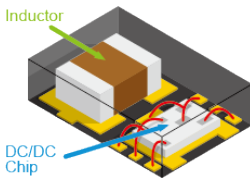
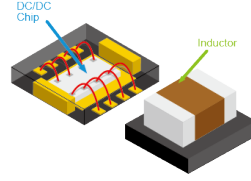
TOREXの電源IC



独自の技術で電子機器の
小型化、省電力化に貢献

● 豊富な構造で、適材適所に対応するTRXの “ micro DC/DC ”

- ・ DC/DCコンバータとコイルを一体化することで、基板の実装面積を削減
- ・ 低ノイズ、小型、高放熱に優れ、あらゆるシーンで高効率で安定した電源回路構成が可能
- ・ 中高耐圧／大電流化に向け、更なる進化を続けています。

構造名	ポケット タイプ	スタック タイプ	マルチプル タイプ	クールポスト タイプ
構造図				
構造説明	ICをコイルで覆ってしまう方法	コイル上にICをスタックする方法	コイルとICを横に並べる方法	モールドされたICにコイルをスタックする方法
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 放射ノイズ ◎ 近傍磁界 △ コスト ◎ 実装面積 ○ 大電流 ○ 放熱 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 放射ノイズ △ 近傍磁界 ◎ コスト ○ 実装面積 △ 大電流 △ 放熱 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 放射ノイズ ○ 近傍磁界 ○ コスト △ 実装面積 ◎ 大電流 ◎ 放熱 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 放射ノイズ ○ 近傍磁界 △ コスト ○ 実装面積 ○ 大電流 ◎ 放熱
製品	XCL100/XCL101 (昇圧) XCL102/XCL103 (昇圧) XCL201/XCL202 (降圧) XCL205/XCL206 (降圧) XCL210 (降圧) XCL232 (降圧)	XCL208/XCL209 (降圧)	XCL211/XC212 (降圧)	XCL104/105 (昇圧)

	トレックス・セミコンダクター	フェニテックセミコンダクター
事業形態	ファブレス	ファウンドリ
主な製品	省エネに貢献するキーデバイスを提供	
	電源IC	ディスクリート パワー半導体 (SiC、GaN、酸化ガリウム)
今後の 重点市場	産業機器 5G、IoTモジュール 全固体電池モジュール 車載機器 自動運転、ADAS、車載カメラ 電子ミラー他、様々なECU	産業機器 産業用ロボット、鉄道、インバータ 発電施設（風力・太陽光）、パワーコンディショナー 車載機器 EV向けパワー半導体 電装品



5G



IoT



自動運転



EV

本資料に記載された内容は、2026年2月13日現在において一般的に入手可能な情報と、合理的と判断する一定の前提に基づき、当社が作成したものです。

本資料に記載されている当社の中期計画、見通し等に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。

実際の業績は、これらの要素により本資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。

投資に関するご決定をされる際、本資料のみに全面的に依拠することはお控えいただき、みなさまご自身のご判断でなされるようお願い致します。